

① 日本国特許庁 (JP) ② 特許出願公開  
② 公開特許公報 (A) 昭63-239676

① Int.Cl. 11  
G 11 C 11/34

識別記号 362  
序内整理番号 G-8522-5B

② 公開 昭和63年(1988)10月5日

特許請求 未請求 発明の数 1 (全14頁)

③ 発明の名称 半導体記憶装置

④ 特 願 昭62-71428  
⑤ 出 願 昭62(1987)3月27日

⑥ 発明者 山口 勤起 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所アバイス  
開発センター内

⑦ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑧ 代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

第 一 巻

1. 発明の名称

半導体記憶装置

2. 特許請求の範囲

1. ノモグラレイを構成する複数のデータ線を介してパラレルに出力される複数の信号を出しデータを受け外部から供給されるクロック信号を使ってシリアルに出力する直並列変換回路と、上記直並列変換回路のシリアル出力動作を開始するタイミング制御回路を含み、上記シリアル出力動作を開始するタイミングが外部から供給される起動制御信号によって選択されてから上記シリアル出力動作を開始するまでの上記クロック信号のサイクル数を指定することによって任意に設定しうるものであることを特徴とする半導体記憶装置。

2. 上記タイミング制御回路は、上記直並列変換回路に同様して外部から供給される上記サイクル数を取り込み上記クロック信号を使ってカウントダウンするカウンタ回路と、上記カウンタ回路の出力信号が全ビット並列"0"になることを検出し

シリアル出力動作を行うための内部クロック信号を形成するタイミング発生回路を含むものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体記憶装置。

3. 上記半導体記憶装置はデュアル・ポート・メモリであり、上記サイクル数はラングム・アクセス・ポート用の複数のデータ入力端子を介して供給されるものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第3項記載の半導体記憶装置。

3. 発明の詳細な説明

(直覚上の利用分野)

この発明は、半導体記憶装置に関するもので、例えば、ラングム入出力機能とシリアル入出力機能をもつて持つ画像処理用のデュアル・ポート・メモリに利用して特に有効な技術に関するものである。

(従来の技術)

文字あるいは图形等をCRT(陰極放電管)の画面上に表示させるための画面上フレームバッファメモリについては、例えば日経マグロウヒル社発

行の1988年3月24日付「日経エレクトロニクス」の143頁～164頁に記載されている。

上記に記載されるデュアル・ポート・メモリには、記憶データを1ビット又は数ビット単位で入出力するためのランダム・アクセス・ポートと、記憶データをメモリアレイのワード線単位でシリアルに入出力するためのシリアル・アクセス・ポートが設けられる。

〔動作が開始しようとする瞬間点〕

このようなデュアル・ポート・メモリには、第4図に示すように、外部から供給される装置信号として、ロウアドレスストローブ信号RAS, カラムアドレスストローブ信号CAS及びライトイネーブル信号WEのほかに、例えばデータ転送制御信号DT/DT, シリアル出力制御信号SC及びシリアルクロック信号SCが設けられる。デュアル・ポート・メモリにおいて読み出しデータのシリアル出力動作が行われる読み出しデータ伝送コードは、ロウアドレスストローブ信号CASがハイレベルからロウレベルに変化された時点である。

新しいシリアルデータ((AX・AY)実際のデータ)の出力動作が開始される。

データ転送制御信号DT/DTが一直ロウレベルとした後、ハイレベルに戻してシリアル出力動作を開始させるタイミングは、このデュアル・ポート・メモリを駆動する外部のメモリ制御回路に設けられた水平位置位置を計数するためのカウンタ回路の出力信号をセエタすることによって算出される。すなわち、デュアル・ポート・メモリの1ワード線に結合されるメモリセルの読み出しデータの出力が待ちに並んだ瞬間でデュアル・ポート・メモリの再起動が行われ、新しいワード線のメモリセルの読み出しデータが対応するデータ線に出力される。その後、メモリ制御回路のカウンタ回路の計数値が装置選択されたワード線に結合されるメモリセルからの読み出しデータのシリアル出力動作の実現を示す値となり、シリアルクロック信号SCがロウレベルとなる瞬間を見計り、データ転送制御信号DT/DTがハイレベルに戻され、詳しく選択されたワード線に結合

カラムアドレスストローブ信号CAS及びライトイネーブル信号WEがハイレベルであり、データ転送制御信号DT/DTがロウレベルであることによって選択される。このとき、ロウアドレスストローブ信号CASの立ち下がりに同期して読み出しを行なワード線のアドレスバスが外部端子A0～A1に供給され、選択されたワード線に結合されるメモリセルからの読み出し信号が対応するデータ線に駆動される。また、ロウアドレスストローブ信号CASにやや遅れてロウレベルとされるカラムアドレスストローブ信号CASの立ち下がりに同期してシリアル出力する先端カラムアドレスAYが外部端子A0～A1に供給される。その後データ転送制御信号DT/DTがハイレベルに戻されることによって、各データ線にパラレルに出力された読み出しデータをシリアル・アクセス・ポートのデータレジスタに転送するためのタイミング信号T4が形成されるとともに、シリアルクロック信号SCに同期して形成されるタイミング信号T4によってデータレジスタに転送され

されるメモリセルからの読み出しデータがデータレジスタに転送され、シリアル出力動作が開始される。これにより、CRTのリットレートに同期したリアルタイムなデータ表示が行われる。

しかしながら、ディスプレイ技術が進展し、高解像度のCRTが開発されることによって、表示データがシリアル出力されるリットレートが高速化してきたため、データ転送制御信号DT/DTがシリアルクロック信号SCに同期して立ち上げることが困難となってきた。すなわち、データ転送制御信号DT/DTをハイレベルに戻すタイミングは、前述のように、メモリ制御回路のカウンタ回路の出力信号をセエタすることで決定される。したがって、シリアルクロック信号SCによってカウンタ回路が歩進する選択時間とその出力信号をデコードしてセエタする選択時間が、シリアルクロック信号SCの周波に比較して相対的に大きくなると、データ転送制御信号DT/DTがシリアルクロック信号SCに同期して立ち上げることが困難となるものである。このため、第4図に

直接で示すように、データ伝送制御信号 $D_{T/R}$ ／ $0$ とシリアルクロック信号 $S_{CK}$ との時間関係が異合できず、特にデータ伝送制御信号 $D_{T/R}$ ／ $0$ の立ち上がりがシリアルクロック信号 $S_{CK}$ の立ち上がりに遅れることによって、誤しく選択されたワード線に結合されるメモリセルからの読み出しデータをデータレジスタに伝送するためのタイミング信号 $D_{T/R}$ ／ $1$ が遅くなる。これにより、シリアルデータ伝送動作が不安定なものとなり、表示画面が亂れてしまう結果となる。

この発明の目的は、シリアルデータ伝送動作の安定化を図ったデュアル・ポート・メモリ等の半導体記憶装置を提供することにある。

この発明の前記ならびにその他の目的と特徴等は、この明細書の記述および図面から明らかになるであろう。

#### (問題点を解決するための手段)

本題において開示される実施例のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通りである。すなわち、デュアル・ポート・メモリのデータ

読み出し路の駆動技術によって、特に制限されないが、高機能シリコンのような1組の半導体基板上において形成される。

この実施例のデュアル・ポート・メモリには、4ビット単位でアクセスされダイナミックRAMを基本構成とするラングム・アッセス・ポートと、ワード線直結で記憶データのシリアル入出力をを行うシリアル・アッセス・ポートが設けられる。これにより、デュアル・ポート・メモリは、一度のシリアル入出力動作を行なうながら同時にラングム・アッセス・ポートのアクセスを行なうことを可能にしている。また、特に制限されないが、ラングム・アッセス・ポートに含まれるラングム入出力路 $R10$ にはラスク換算等を行うための論理換算回路が設けられ、この論理換算回路を制御するための論理制御回路 $D10$ が設けられる。論理換算回路には論理取扱い回路や論理和等の各種の演算方法が用意され、どの演算を行うかは論理信号の特定の組み合わせにおいてアドレス信号用外部端子 $A10$ ～ $A13$ を介して入力される演算コードによって指

す。転送時において、読み出しデータのデータレジスタへの転送動作を開始するタイミングをデータ伝送タイミング制御信号 $D_{T/R}$ ／ $0$ の立ち上がりがシリアルクロック信号 $S_{CK}$ の立ち上がりに遅れることによって任意に設定できるようにするものである。

#### (作成用)

上記手数によれば、デュアル・ポート・メモリのデータ伝送動作を起動する時点においてメモリ制御路のカウンタ回路の計数値に従って転送動作を開始するクロック信号位置を任意に指定することができ、またデュアル・ポート・メモリ内に設けられるカウントダウン用のカウンタ回路によりクロック信号に同期した転送動作を行うことができるため、表示データの転送動作の安定化を図ったデュアル・ポート・メモリ等の半導体記憶装置を実現するものである。

#### (実施例)

第2図には、この発明が適用されたデュアル・ポート・メモリの一実施例のブロック図が示されている。両図の各回路ブロックは、公知の半導体

である。

シリアル・アクセス・ポートには、シリアル入出力端子 $S101$ ～ $S104$ が設けられ、運算4つのシリアル入出力端子 $S101$ ～ $S104$ を介して、4つのメモリアレイに対応する記憶データが同時にシリアルに入出力される。また、演算コードの特定の組み合わせにおいて、4つのメモリアレイから出力される読み出しデータをシリアル入出力端子 $S101$ を介して交互に出力するいわゆる $\times 1$ ビット構成のメモリとして使用することもできる。

デュアル・ポート・メモリには、外部の記憶から、通常のダイナミックRAMで用いられるロウアドレスストローブ信号 $WA$ 、カラムアドレスストローブ信号 $CAS$ 及びライトイネーブル信号 $WE$ 等の制御信号の他、出力制御及びラングム・アッセス・ポートとシリアル・アッセス・ポートとの間のデータ伝送制御に用いられるデータ伝送制御信号 $D_{T/R}$ ／ $0$ と、シリアル・アッセス・ポートの入出力切り替え制御に用いられるシリアル出力制御信号 $S105$ 及びシリアル入出力時に

いて同期信号として用いられるシリアルクロック信号SCが入力される。

この実施例のデュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポートには、特に制限されないが、4つのメモリアレイM-ARY1～M-ARY4が設けられ、それぞれのメモリアレイに対応してセンサアンプSA1～SA4、カラムスイッチCSWI～CSW4が設けられる。また、メモリアレイM-ARY1～M-ARY4に先端に、ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードRCRD及びロウアアドレスデコードRCRDが設けられる。これらのアドレスデコードは、半導体基板上のメモリアレイの配置に応じて、複数回設けられることもある。第3図には、メモリアレイM-ARY1とその周囲回路が例示的に示されている。

第3図において、メモリアレイM-ARY1は、同図の垂直方向に配置されるn+1本のワード線と、同図の水平方向に配置されるn+1組の相補データ線及びこれらのワード線と相補データ線の

交点に配置される(n+1)×(n+1)個のメモリセルにより構成される。

メモリアレイM-ARY1を構成するダイナミック型メモリセルは、信号蓄積用キャパシタとアドレス選択用MOSFETにより構成される。同一の行に配置されるn+1個のメモリセルのアドレス選択用MOSFETのゲートは、対応するワード線に結合される。各ワード線は、さらにロウアアドレスデコードRCRDに結合され、Xアドレス信号AX0～AX1に指定される一本のワード線が選択・開閉される。

ロウアアドレスデコードRCRDは、ロウアアレスバッファRCDBから供給される相補内部アドレス信号 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ （ここで、例えば外部から供給されるXアドレス信号AX0と同様の内部アドレス信号 $\overline{A_0}$ と相補の内部アドレス信号 $\overline{A_1}$ をあわせて相補内部アドレス信号 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ のように表す。以下同じ）をデコードし、Xアドレス信号AX0～AX1に指定される一本のワード線を選択し、ハイレベルの選択状態とする。ロウアア

スデコードRCRDによるワード線の選択動作は、タイミング制御回路TCから供給されるワード線選択タイミング信号 $\overline{ref}$ に従って行われる。

ロウアアレスバッファRCDBは、アドレスマルチプレクサAMXから供給されるロウアアドレス信号を受け、相補内部アドレス信号 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ と $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ を形成して、ロウアアドレスデコードRCRDに供給する。この実施例のダイナミック型RAMでは、ロウアアドレスを指定するためのXアドレス信号AX0～AX1とカラムアドレスを指定するためのYアドレス信号AY0～AY1は、同一の外部端子 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ を介して可分割されて供給されるいわゆるアドレスマルチプレクサ方式を探っている。したがって、外部から制御信号として供給されるロウアアレスストローブ信号 $\overline{RAS}$ の立ち下がりに同期してXアドレス信号AX0～AX1が、またカラムアドレスストローブ信号 $\overline{CAS}$ の立ち下がりに同期してYアドレス信号AY0～AY1がそれぞれ外部端子 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ に供給される。さらに、この実施例のダイナミック型RAMには、ノ

メモリセルの記憶データを所定の周期間に読み出し・再書き込みするための自動リフレッシュモードが設けられ、この自動リフレッシュモードにおいてリフレッシュすべきワード線を指定するためのリフレッシュアドレスカウンタREFCが設けられる。

アドレスマルチプレクサAMXは、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 $\overline{ref}$ に従って、外部端子 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ を介して供給されるXアドレス信号AX0～AX1とリフレッシュアドレスカウンタREFCから供給されるリフレッシュアドレス信号 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ を選択し、ロウアアドレス信号としてロウアアレスバッファRCDBに供給する。すなわち、タイミング信号 $\overline{ref}$ がロウレベルとされる通常のメモリアクセスモードにおいて、外部端子 $\overline{A_0} \sim \overline{A_1}$ を介して外部の端部から供給されるXアドレス信号AX0～AX1を選択し、タイミング信号 $\overline{ref}$ がハイレベルとされる自動リフレッシュモードにおいて、リフレッシュアドレスカウンタREFCから出力

されるリフレッシュアドレス信号 $\text{CS0-CS1}$ を選択する。

前述のように、Xアドレス信号 $\text{AX0-AX1}$ はロウアドレスストローブ信号 $\text{RA3}$ の立ち下がりに同期して外部端子 $\text{A0-A1}$ に供給されるため、ロウアドレスバッファ $\text{RADB}$ によるロウアドレス信号の取り込みは、タイミング制御回路 $\text{TC}$ においてロウアドレスストローブ信号 $\text{RA3}$ の立ち下がりを検出して形成されるタイミング信号 $\text{t1}$ に従って行われる。

一方、ノモリアレイ $\text{M-ARY1}$ の同一の列に配置されるノモリセルのアドレス選択用MOSFETのドレインは、対応する相補データ線に結合される。ノモリアレイ $\text{M-ARY1}$ の各相補データ線は、その一方において、カラムスイッチ $\text{CSW1}$ の対応するスイッチMOSFETに結合され、さらに選択的に相補共通データ線 $\text{CD1}$ （ここで、相補共通データ線の本反転信号線 $\text{CD1}$ 及び反転信号線 $\text{CD1}$ をあわせて相補共通データ線 $\text{CD0}$ のように表す。以下同じ）に接続される。

カラムアドレスバッファ $\text{CADD}$ は、タイミング制御回路 $\text{TC}$ においてカラムアドレスストローブ信号 $\text{RA3}$ の立ち下がりを検出して形成される対応する信号 $\text{t1}$ に従って、外部端子 $\text{A0-A1}$ を介して供給されるYアドレス信号 $\text{AY0-AY1}$ を入力し、選択するとともに、相補内部アドレス信号 $\text{A0-A1}$ を形成してランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダ $\text{RC0}$ に供給する。

ノモリアレイ $\text{M-ARY1}$ の各相補データ線は、その他において、センスアンプ $\text{SA1}$ の対応する位相回路に結合され、さらにシリアル・アクセス・ポートのデータレジスタ $\text{DR1}$ の対応する位相回路に結合される。

センスアンプ $\text{SA1}$ の各単位回路は、突波検出される二つのCMOSインバータ構成からなるチャネルをその基本構成とする。これらのセンスアンプ単位回路は、タイミング制御回路 $\text{TC}$ から供給されるタイミング信号 $\text{t1}$ によって動作状態とされ、各ノモリセルから対応する相補データ線に出

カラムスイッチ $\text{CSW1}$ は、それぞれ対応する相補データ線に結合される $\text{A0-A1}$ 列のスイッチMOSFETによって構成される。これらのスイッチMOSFETの他方の端子は、相補共通データ線を構成する反転信号線 $\text{CD1}$ 又は反転信号線 $\text{CD1}$ に共通に結合される。これにより、カラムスイッチ $\text{CSW1}$ は $\text{A0-A1}$ 列の相補データと共通相補データ線 $\text{CD1}$ とを選択的に接続させる。カラムスイッチ $\text{CSW1}$ を構成する各列の二つのスイッチMOSFETのゲートはそれぞれ共通接続され、ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダ $\text{RC0}$ によって形成されるデータ選択信号がそれぞれ供給される。

ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダ $\text{RC0}$ は、カラムアドレスバッファ $\text{CADD}$ から供給される相補内部アドレス信号 $\text{A0-A1}$ をデコードし、タイミング制御回路 $\text{TC}$ から供給されるデータ線選択タイミング信号 $\text{t1}$ に従って、上記データ線選択信号を形成し、カラムスイッチ $\text{CSW1-CSW4}$ に供給する。

力される最小読み出し信号を増幅し、ハイレベル/ロウレベルの2種信号とする。

Yアドレス信号 $\text{AY0-AY1}$ に指定される相補データ線が選択的に接続される相補共通データ線 $\text{CD1}$ は、ランダム・アクセス・ポート用入出力回路 $\text{R10}$ に結合される。このランダム・アクセス・ポート用入出力回路 $\text{R10}$ には、ノモリアレイ $\text{M-ARY2-M-ARY4}$ に対応して設けられる相補共通データ線 $\text{CD3-CD4}$ が同時に結合される。

ランダム入出力回路 $\text{R10}$ は、デュアル・ポート・ノモリのランダム・アクセス・ポート書き込み動作モードにおいて、タイミング制御回路 $\text{TC}$ から供給されるタイミング信号 $\text{t1}$ によって動作状態とされ、入出力端子 $\text{I01-I04}$ を介して外部の記憶から供給される書き込みデータを相補書き込み信号とし、相補共通データ線 $\text{CD1-CD4}$ に接続する。また、デュアル・ポート・ノモリのランダム・アクセス・ポート読み出し動作モードにおいて、タイミング制御回路 $\text{TC}$ から供給

されるタイミング信号 $\phi_{10}$ によって動作状態とされ、相補共通データ線 $D1 \sim D4$ を介して送達されるノモリセルの読み出し2信号をさらに増幅し、入出力端子 $I01 \sim I04$ から送出する。さらに、このランダム入出力回路 $R10$ には、特に制限されないが、リード・セティファイ・ライト機能を用いて、ノモリセルから読み出したデータと入力データとの間で種々の演算を行い算出値を凸むための論理演算回路が設けられる。この論理演算回路には、ラスク演算等の処理を行うための各種の演算コードが用意される。

論理演算回路の演算コードは、論理制御回路 $PC$ によって指定される。論理制御回路 $PC$ は、外部端子 $A0 \sim A3$ を介して供給される演算コードを保持するためのレギスタと、その演算コードをデコードし論理演算回路の演算コードを選択・指定するためのデコーダを含む。演算コードは、カラムアドレスストローブ信号 $CAS$ がロウアドレスストローブ信号 $RA$ に先立ってロウレベルとされ、同時にライトイネーブル信号 $WE$ がロウレ

ベルとされる組み合せにおいて、外部端子 $A0 \sim A3$ を介してデュアル・ポート・メモリに供給される。また、演算コードの特定の組み合せには、後述するシリアル入出力回路 $S100$ の出力をいわゆる $\times 1$ ビット構成とするための内部制御信号 $\#$ として用いられる。

データ入出力用外部端子 $I01 \sim I04$ には、後述するように、デュアル・ポート・メモリのシリアル読み出し動作モードにおいて、履歴後シリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号 $SC$ のサイクル数が入力される。これにより、この実施例のデュアル・ポート・メモリは、履歴後シリアル出力動作を開始するタイミングを任意に設定することができ、高速ドットレートに対応して短い周期とされるシリアルクロック信号 $SC$ に安定して同期化されたシリアル出力動作を行なうことができる。データ入出力用外部端子 $I01 \sim I04$ に入力されるサイクル数は、内部信号 $I01 \sim I04$ として、タイミング制御回路 $TC$ に送られる。

一方、この実施例のデュアル・ポート・メモリのシリアル・アクセス・ポートは、各ノモリアレイの相補データ線に対応して設けられる $\# + 1$ ビットのデータレジスタ $DR1 \sim DR4$ と、データセレクタ $DSL1 \sim DSL4$ 及びこれらの4つのデータレジスタとデータセレクタに共通に設けられるポイント $PNT$ 、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード $SCD$ 及びシリアル入出力回路 $S10$ によって構成される。また、ポイント $PNT$ 及びシリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード $SCD$ は、半導体基板上におけるノモリアレイの配置の關係で複数個設けられることもある。

データレジスタ $DR1$ は、ノモリアレイ $MR1 \sim RY1$ の各相補データ線に対応して設けられるデータラッチ用の $\# + 1$ 個のフリップフロップを含む。これらのフリップフロップの入出力ノードと対応する相補データ線の高速起信号線及び反転信号線の間に、データ送達用のスイッチ $MOSFET$ がそれぞれ設けられ、そのゲートにはタイミング

制御回路 $TC$ からデータ送達用のタイミング信号 $\phi_{10}$ が供給される。

データレジスタ $DR1$ の各ビットは、さらにデータセレクタ $DSL1$ の選択するスイッチ $MOSFET$ に結合される。データセレクタ $DSL1$ は、上端のカラムスイッチ $CSW1$ と同様に構成され、データレジスタ $DR1$ の各ビットとシリアル入出力用相補共通データ線 $D31$ を選択的に接続する。データセレクタ $DSL1$ の各対のスイッチ $MOSFET$ のゲートはそれぞれ共通接続され、ポイント $PNT$ からレジスタ選択信号が供給される。

ポイント $PNT$ は、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコード $SCD$ によって指定されるシリアル動作開始ビットを保持するラッチ回路（ポイントラッチ）と、 $\# + 1$ ビットのシフトレジスタ及びこれらの間に設けられるNチャンネル $MOSFET$ からなるスイッチ回路とにより構成される。シフトレジスタの最終ビットの出力端子 $\#$ はその先頭ビットの入力端子に結合され

る。また、これらのスイッチMOSFETのゲートには、上記タイミング信号 $\phi_1$ が共通に供給される。ポイントPNTのシフトレジスタは、デュアル・ポート・メモリのシリアル入出力モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるシフトクロック用タイミング信号 $\phi_1$ に従って、ループ状のシフト動作を行う。ポイントラッチ回路に供給された選択信号は、タイミング信号 $\phi_1$ がハイレベルとされることによって、シフトレジスタの初期値として供給される。

シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダSCDは、カラムアドレスバッファCA RDDから供給される相補内部アドレス信号 $\overline{A_0} \sim \overline{A_{15}}$ をデコードし、 $\overline{A_0}$ アドレス信号 $A_0 \sim A_{15}$ で指定されるシリアル入出力の先頭ビットに対応するポイントPNTのビットのみを拾取 $\phi_1$ とする。すなわち、シリアル入出力モードにおいては、 $\overline{A_0}$ アドレス信号 $A_0 \sim A_{15}$ によってワード線が選択され、 $\overline{A_0}$ アドレス信号 $A_0 \sim A_{15}$ によってシリアル入出力するべき先頭のカ

データレジスタDR1に取り込まれる。同時にポイントPNTでは、タイミング信号 $\phi_1$ のハイレベルによってポイントラッチに保持される選択信号がシフトレジスタに初期値として供給される。読み出しデータは、ポイントPNTから次々に選択されるレジスタ選択信号に従って、シリアル入出力用相補共通データ線 $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ を介してシリアル入出力回路S10に送られる。一方、デュアル・ポート・メモリのシリアル書き込み動作モードにおいて、シリアル入出力端子 $S10 \sim S10$ からシリアル入出力回路S10を介してシリアルに入力される書き込みデータは、ポイントPNTから次々に選択されるレジスタ選択信号に従って、データレジスタDR1の対応するビットに直接入力される。データレジスタDR1に保持された書き込みデータは、タイミング信号 $\phi_1$ がハイレベルとされることによって、メモリアレイM-ARY1の選択されたワード線に結合される $\overline{S} + 1$ 箇のメモリセルに一齊に書き込まれる。

シリアル入出力回路S10は、シリアル入出力

ラムアドレスが固定される。シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダSCDによってポイントPNTの指定されたビットに書き込まれた結果 $\phi_1$ の信号は、タイミング信号 $\phi_1$ に従ってポイントPNT内をループ状にシフトされる。この結果 $\phi_1$ の信号がシフトされることによって、データセレクタ $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ には複数ハイレベルのレジスタ選択信号が供給され、データレジスタDR1の各ビットが次々にシリアル入出力用相補共通データ線 $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ に接続される。これにより、この実現例のデュアル・ポート・メモリは、記憶データのシリアル入出力を任意のカラムアドレスから開始することができ、例えば隣接メモリにおけるスクロール処理等を高速化することができる。

以上のことから、デュアル・ポート・メモリのシリアル読み出し動作モードにおいて、メモリアレイM-ARY1の $\overline{S} + 1$ 箇の相補データ線から、出力される $\overline{S} + 1$ ビットの読み出しデータは、タイミング信号 $\phi_1$ がハイレベルとされることによって

用相補共通データ線 $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ 及びシリアル入出力端子 $S10 \sim S10$ に対して既に接続される4つのメインアンプとデータ入力バッファ及びデータ出力バッファを含む。シリアル入出力回路S10のデータ出力バッファは、デュアル・ポート・メモリの読み出しデータ線 $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ において、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 $\phi_1$ のハイレベルによって動作状態とされ、対応するシリアル入出力用相補共通データ線 $\overline{D_3} \sim \overline{D_0}$ を介して出力され対応するメインアンプによって増幅される読み出しデータを、シリアル入出力端子 $S10 \sim S10$ から外部の装置に出力する。また、シリアル入出力回路S10のデータ入力バッファは、デュアル・ポート・メモリのシリアル書き込み動作モードにおいて、タイミング制御回路TCから供給されるタイミング信号 $\phi_1$ のハイレベルによって動作状態とされ、対応するシリアル入出力端子 $S10 \sim S10$ を介して外部の装置から供給される書き込みデータを相補書き込み信号とし、対応す

各シリアル入出力用相補共通データ線 $\overline{S1-S4}$ に接続する。シリアル入出力端子 $S10$ の記憶データにおけるシリアル入出力動作は、タイミング制御回路 $TC$ において外部から供給されるシリアルクロック信号 $SC$ をもとに形成されるタイミング信号 $CS$ によって行われる。

この実施例のデュアル・ポート・メモリでは、通常シリアル入出力端子 $S10$ のシリアル出力信号は、上記のように4つのシリアル入出力端子 $S101-S104$ を介して1ビット同時に出力される。しかし、さらに記憶容量の大きなシリアルメモリを実現したい場合、このデュアル・ポート・メモリを、4つのメモリアレイ $M-ARY1-M-ARY4$ から出力される読み出しデータを一つのシリアル入出力端子を介してシリアルに出力するいわゆる $\times 1$ ビット構成のメモリとして用いることができる。この場合、通常のように、ランダム入出力端子 $S10$ の論理接続回路の接点セードを制御するための接点コードの組み合わせの一つが、シリアル出力を $\times 1$ ビット構成とするため

の内部制御信号 $CS$ とされる。シリアル入出力端子 $S10$ は、通常制御回路 $TC$ から供給される内部制御信号 $CS$ がハイレベルになると、4組のシリアル入出力用相補共通データ線 $\overline{S1-S4}$ を介してそれぞれシリアルに出力される読み出しデータを、シリアル入出力端子 $S10$ 間に接続されるマルチプレクサによって順次選択し、一つのシリアル入出力端子 $S101$ を介して外部の端記に出力する。このシリアル出力は、タイミング制御回路 $TC$ から供給されるタイミング信号 $CS$ によって行われるため、4つのシリアル入出力端子 $S101-S104$ によって同時に1ビットのシリアル出力が行われる場合の各入出力端子のデータレートと同じデータレートとなる。

タイミング制御回路 $TC$ は、外部から制御信号として供給されるロウアドレスストローブ信号 $\overline{RA}$ 、カラムアドレスストローブ信号 $\overline{CA}$ 、ライトイネーブル信号 $\overline{WE}$ 、データ経路制御信号 $\overline{D/DR}$ 及びシリアル出力制御信号 $\overline{CS}$ によって、上記各組のタイミング信号を形成し、各回路

に供給する。また、外部から供給されるシリアルクロック信号 $SC$ により、シリアル入出力動作を同期化するためのタイミング信号 $CS$ を形成し、シリアル入出力端子 $S10$ に供給する。

各制御信号が適当な組み合わせとされることで、デュアル・ポート・メモリの動作モードが選択される。例えば、まずロウアドレスストローブ信号 $\overline{RA}$ がロウレベルとなり、続いてカラムアドレスストローブ信号 $\overline{CA}$ がロウレベルとなり、続いてライトイネーブル信号 $\overline{WE}$ がハイレベルであると、通常のランダム・アクセス・ポートの読み出し動作モードとされる。ロウアドレスストローブ信号 $\overline{RA}$ がロウレベルとなり、続いてカラムアドレスストローブ信号 $\overline{CA}$ がロウレベルとなる時点でライトイネーブル信号 $\overline{WE}$ がロウレベルである場合、通常のランダム・アクセス・ポートの書き込み動作モードあるいは接点信号を込み動作モードとされる。さらに、ロウアドレスストローブ信号 $\overline{RA}$ の立ち下がり時点でライトイネーブル信号 $\overline{WE}$ がハイレベルでありデータ経路制御信号

$\overline{D/DR}$ がロウレベルの場合、メモリアレイの読み出しデータをデータレジスタ $DR1-DR4$ に搬送するいわゆるシリアル読み出しを行なうための読み出しデータ経路モードとされる。

前述のように、この実施例のデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ経路モードでは、ロウアドレスストローブ信号 $\overline{RA}$ のロウレベルへの立ち下がりに同期して、データ入出力用外部端子 $S101-S104$ に接続後次のシリアル読み出しデータのデータ経路動作を開始するまでのシリアルクロック信号 $SC$ のタイミングが設定される。このため、タイミング制御回路 $TC$ には、データ入出力端子 $S101-S104$ を介して入力されるタイミング数を取り込み、シリアルクロック信号 $SC$ に従ってカウントダウンするためのカウンタ回路 $CTR$ が接続される。各データ端に出力された読み出しデータは、タイミング制御回路 $TC$ のカウンタ回路 $CTR$ の計数値が $00$ となることによって形成されるタイミング信号 $CS$ によってデータレジスタ $DR1-DR4$ に搬送され、さらにタイ

シングル端子 $\ominus$ に使ってシリアル入出力端子S10からシリアル入出力端子S101-S104を介して外部に出力される。

次に、タイミング制御回路TCは、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でデータ転送制御信号DT/0ととともにライトイネーブル信号WEがロウレベルでありかつシリアル入出力制御信号S0Eがハイレベルの場合は、デュアル・ポート・メモリをシリアル書き込み動作モードとし、シリアル入出力端子S101-S104を介して供給されるシリアル書き込みデータがデータレジスタDR1-DR4に入力される。また、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でデータ転送制御信号DT/0ととともにライトイネーブル信号WEがロウレベルでありかつシリアル入出力制御信号S0Eがロウレベルの場合は、書き込みデータ転送モードとされ、転送用タイミング信号 $\ominus$ が形成される。これにより、データレジスタDR1-DR4の転送用スイッチMOSFETがオン状態とされて、上記シリ

アル書き込み動作モードによってデータレジスタDR1-DR4にセットされた書き込みデータがメモリアレイの選択されたワードに結合される $\ominus$ 1ビットのメモリセルに一度に入力される。デュアル・ポート・メモリのシリアル・アクセス・ポートを用いたシリアル書き込み動作は、上記のシリアル書き込み動作モードを実行した後、書き込みデータ転送モードを組み合わせて実行することによって、実現される。

一方、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに先立って、カラムアドレスストローブ信号CASがハイレベルからロウレベルに変化される場合、いわゆるCASビットアクセスフレッシュモードとされる。また、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がり時点でライトイネーブル信号WEがロウレベルであると、接掌セーフ設定タイタルとされ、外部端子A1-A3を介して供給される接掌コードが接掌制御回路PC内のレジスタに取り込まれる。

上記接掌コード設定サイタルを除く各動作モードにおいては、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに同期して、ワード幅を指定するためのXTアドレス信号AX0-AX1が外部端子A0-A1に供給され、またカラムアドレスが必要な動作モードにおいては、カラムアドレスストローブ信号CASの立ち下がりに同期して、相対データ幅を指定するためのYアドレス信号AY0-AY1が外部端子A0-A1に供給される。

第一回には、第二回のデュアル・ポート・メモリにおけるタイミング制御回路TCの一環の一実施例の回路図が示されている。

前述のように、この実施例のデュアル・ポート・メモリでは、データ入出力用外部端子101-104を介して、ロウアドレスストローブ信号RASがロウレベルとなりデュアル・ポート・メモリが起動されてから読み出しデータのデータ転送動作が開始されるまでのシリアルクロック信号SCKのサイクル数が2進表示により固定される。これらのサイクル数は、内部データ101-104としてタイミング制御回路TCのカウンタ回路C

TRに内蔵するビットに供給される。

カウンタ回路CTRには、タイミング制御回路TC内に設けられる他のタイミング発生回路から、ロウアドレスストローブ信号RASの立ち下がりに同期して形成されるタイミング信号 $\ominus$ ccが供給される。また、両回のタイミング制御回路TC内で形成される歩進用のタイミング信号 $\ominus$ ccが供給される。

カウンタ回路CTRの各ビットの反転出力信号 $\overline{C1}-\overline{C8}$ は、アンドゲート回路AC1の4つの入力端子にそれぞれ入力される。アンドゲート回路AC1の出力信号 $\ominus$ ccは、カウンタ回路CTRの反転出力信号 $\overline{C1}-\overline{C8}$ がすべて始振 $\ominus$ すなわちカウンタ回路CTRの計数値が“0”であるときハイレベルとされる。

アンドゲート回路AC1の出力信号 $\ominus$ ccは、アンドゲート回路NAC1の一方の入力端子に供給されるとともに、インバータ回路NIにより反転され、アンドゲート回路AC2の一方の入力端子に供給される。アンドゲート回路NAC1の後

方の入力端子には、ロウアドレスストローブ信号 DATA のハイレベルからロウレベルへの立ち下がりにおいて、カラムアドレスストローブ信号 DATA 及びライトイネーブル信号 WE がハイレベルとされかデータ・タブ接続信号 DT/0E がロウレベルとされることでセットされる請求されないフリップフロップの出力信号 Q が、通常な選択平成 (例えば偶数個のインバータ回路) D を介して供給される。つまり、このフリップフロップの出力信号 Q は、デュアル・ポート・メモリの読み出しデータ接続タイトルを規定するためのセード信号として用いられる。これにより、 NAND ゲート回路 NAG1 の出力信号は、アンドゲート回路 AG1 の出力信号 DATA とセード信号 Q がハイレベルである時にロウレベルとなる。 NAND ゲート回路 NAG1 の出力信号は、一方において、通常な選択平成 D によって選択されさらにインバータ回路 N4 によって反転された後、ノアゲート回路 NA01 の一方の入力端子に入力される。また、 NAND ゲート回路 NAG1 の出力信号

は、他方において、そのままノアゲート回路 NA01 の他方の入力端子に入力される。ノアゲート回路 NA01 の出力信号は、タイミング信号 CK としてボインクリンプ PNT に供給される。つまり、このタイミング信号 CK は、セード信号 Q がハイレベルとされるデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ接続モードにおいて、アンドゲート回路 AG1 の出力信号 DATA がハイレベルとなるとき、所定の期間だけ一時的にハイレベルとなるものとなる。

一方、アンドゲート回路 AG2 の他方の入力端子には、インバータ回路 N1 及び N2 を介してシリアルクロック信号 SC が供給される。これにより、アンドゲート回路 AG2 の出力信号は、アンドゲート回路 AG1 の出力信号 DATA がロウレベルでインバータ回路 N3 の出力信号がハイレベルすなわちカウンタ回路 CTR の計数値が “0” でなく、シリアルクロック信号 SC がハイレベルであるときに、ハイレベルとなる。つまり、アンドゲート回路 AG2 の出力信号は、カウンタ回路

CTR の計数値が “0” に達するまでカウンタ回路 CTR をカウントダウンさせるための歩道用タイミング信号 CK となる。また、インバータ回路 N1 及び N2 を通ったシリアルクロック信号 SC は、タイミング信号 CK となる。

第3回には、第4回のタイミング制御回路 TC を含むデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ接続モードにおける動作を規定するための一実施例のタイミング圖が示されている。この図により、この実施例のデュアル・ポート・メモリの読み出し接続モードの概要を概要する。

第3回において、このデュアル・ポート・メモリは、ロウアドレスストローブ信号 DATA がハイレベルからロウレベルに変化されることによって起動される。このロウアドレスストローブ信号 DATA の立ち下がりに先立って、カラムアドレスストローブ信号 CAS 及びライトイネーブル信号 WE がハイレベルとされ、データ接続制御信号 DT/0E がロウレベルとされる。また、外部端子 A0 ～ A1 にはワード幅を指定するための X アドレ

ス信号 AX0 ～ AX1 が供給され、データ入出力用外部端子 I01 ～ I04 にはロウアドレスストローブ信号 DATA の立ち下がりから読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでのシリアルクロック信号 SC のタイトル数 NT が供給される。

このタイトル数 NT は、デュアル・ポート・メモリの外側に設けられるメモリ制御回路に含まれ CTR の水平選択位置を制御するためのカウンタ回路の計数値を使って決定される。すなわち、1ワード粒分の読み出しデータの末尾ビットに対応する計数値を N1 とし、ロウアドレスストローブ信号 DATA を立ち下げる時点での計数値を N2 とすると、タイトル数 NT は、

NT = N1 - N2

として求められる。このタイトル数 NT は、以上の式を満足し、かつデュアル・ポート・メモリのランダム・アクセス・ポートにおいて読み出しデータが確立されるまでの時間と選択位置に決定される。

ロウアドレスストローブ信号R A 3の立ち下がりにやや遅れて、カラムアドレスストローブ信号C A 3がハイレベルからロウレベルに変化される。このカラムアドレスストローブ信号C A 3の立ち下がりに先立って、外部端子A 0-A 1には、シリアル出力動作において先頭に出力するデータ線のアドレスがYアドレス信号A Y 0-A Y 1として供給される。ロウアドレスストローブ信号R A 3、カラムアドレスストローブ信号C A 3、ライトイネーブル信号WE及びデータ転送制御信号D T N/O Eは、カウンタ回路CTRの計数値が“0”となりシリアル出力動作が開始された後、ハイレベルに戻される。

デュアル・ポート・メモリでは、ロウアドレスストローブ信号R A 3の立ち下がりによって、Xアドレス信号A X 0-A X 1がロウアドレスバッファR A D Bに取り込まれ、ワード線の選択動作が行われる。また、ロウアドレスストローブ信号R A 3の立ち下がりによってモード信号M 0がハイレベルになるととともにタイミング信号T 0が

が形成され、データ入出力用外部端子S 10-L-1-S 0-4に供給されるタイミング信号T 0がカウンタ回路CTRに取り込まれる。これにより、カウンタ回路CTRの出力は“0”以外の数値となり、第1回のアンドゲート回路A G 1の出力信号T 0はロウレベルとされる。このアンドゲート回路A G 1の出力信号のロウレベルすなわちインバータ回路N 3の出力信号のハイレベルにより、アンドゲート回路A G 2の出力信号すなわちカウンタ回路CTRの歩進用タイミング信号T 0が形成される。カウンタ回路CTRは、このタイミング信号T 0の立ち下がりによって、取り込まれたタイミング信号T 0から“0”に向かってカウントダウンを開始する。

カウンタ回路CTRによるシリアルクロック信号S Cのカウントダウンが行われている間に、デュアル・ポート・メモリではワード線の選択動作が終了し、選択されたワード線に結合される。1回のメモリセルからの読み出しデータがそれぞれ対応する相補データは上に區別される。また、

カラムアドレスストローブ信号C A 3の立ち下がりによって、Yアドレス信号A Y 0-A Y 1が取り込まれ、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDによるデータ転送制御動作が開始される。このシリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDによるデコード結果が終了するタイミングで、タイミング信号T 0が形成され、ボインクP N TのYアドレス信号A Y 0-A Y 1に対応するビットに論理“1”がセットされる。

カウンタ回路CTRによるカウントダウンが進み、その計数値が“1”になると、アンドゲート回路A G 1の出力信号T 0がハイレベルとされる。これにより、モードインバータ回路N 3の出力信号T 0がハイレベルとなり、カウンタ回路CTRの歩進用タイミング信号T 0が停止される。また、タイミング信号T 0が形成され、各データ線に確立された読み出しデータがデータレジスタD R 1-D R 4に転送される。また、タイミング信号T 0が、シリアル入出力回路S 10のデータ出力バ

ッファD O Sを制御するシリアル出力制御信号T 0に用意して形成される。

タイミング信号T 0のハイレベルにより、シリアル入出力端子S 101-S 104はハイインバーダンス状態H 1からYアドレス信号A Y 0-A Y 1によって指定される先頭アドレスの読み出しデータに応じたレベルとされる。これにより、読み出しデータの出力動作が開始される。

タイミング回路CTRでは、モード信号M 0及びアンドゲート回路A G 1の出力信号T 0のハイレベルによって、シリアルクロック信号S Cに用意したシフト用タイミング信号T 0が形成され、シリアル入出力回路S 10及びボインクP N Tに供給される。これにより、シリアル・アクセス・ポート用カラムアドレスデコードSCDの選択動作によりボインクP N TのYアドレス信号A Y 0-A Y 1に対応するビットにセットされた論理“1”的信号はループ状にシフトされ、データレジスタD R 1-D R 4に保持された読み出しデータが、シリアル入出力用相補共通データ線

S10S1-S10S4 及びシリアル入出力端子 S100 を介してシリアル入出力端子 S101-S104 に出力される。タイミング信号  $\phi_1$  によるタイミング PNT のシフト動作は、タイミング信号のロウレベルからハイレベルへの立ち上がりに同期して行われる。また、タイミング PNTにおいて、タイミング信号  $\phi_1$  の先頭パルスは無視され、先頭データの出力時間幅が確保される。

タイミング信号  $\phi_1$  による読み出しデータのシリアル出力動作が進み、末尾の読み出しデータの出力が終了すると、シリアル出力制御信号 S0E がハイレベルに戻される。このシリアル出力制御信号 S0E のハイレベルによって、セード信号  $\phi_2$  がロウレベルとされ、シリアル出力用のタイミング信号  $\phi_2$  がシリアルタロック信号 SC の立ち上がりに同期してロウレベルとされる。これにより、デュアル・ポート・メモリのシリアル出力動作は停止され、シリアル入出力端子 S101-S104 はハイインピーダンス状態とされる。

以上のように、この実施例のデュアル・ポート

メモリでは、読み出しデータ伝送モードにおいて、ロウアドレスストローブ信号 RAS の立ち下がりに同期して、ロウアドレスストローブ信号 RAS の立ち下がりから読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルタロック信号 SC のサイクル数  $\phi_1$  が指定される。このサイクル数  $\phi_1$  は、タイミング制御回路 TC に設けられるカウンタ回路 CTR に初期セットされ、カウントダウンが行われる。カウンタ回路 CTR によるカウントダウンが終了し、その計数値が “0” になった時点で、読み出しデータのシリアル出力動作が開始される。このため、外部に設けられる CTR が高精度化され、表示データのドットレートが非常に高速化されているにもかかわらず、シリアルタロック信号 SC と CTR のスキャンタイミングに確実に同期してデュアル・ポート・メモリのシリアル出力動作が行われ、安定した表示画面を得ることができるものである。

以上の本実施例に示されるように、この発明を直接実用メモリとして用いられるデュアル・ポ

ート・メモリ等の半導体記憶装置に適用した場合、次のような効果が得られる。すなはち、

① デュアル・ポート・メモリの読み出しデータ伝送モードにおいて、起動制御信号に同期して、起動後から読み出しデータのシリアル出力動作を開始するまでの間のシリアルタロック信号のサイクル数を指定し、タイミング制御回路 TC に設けられるカウンタ回路によってカウントダウンすることによってタイミング整合を行っているが、外部から供給されるシリアルタロック信号 SC のサイクル数  $\phi_1$  をレジスタに保持するとともにカウンタ回路 CTR をカウントアップさせ、カウンタ回路 CTR の出力とレジスタにセットされるサイクル数  $\phi_1$  とが一致したときにシリアル出力動作を開始させるようにしてよい。また、サイクル数  $\phi_1$  をデコードし、測定設けられるシフトレジスタの対応するビットに論理 “1” をセットした後、シリアルタロック信号 SC によってシフトレジスタをシフトさせ、この論理 “1” が所定の位置に達したことによってシリアル出力動作を開始させる方法もよい。この実施例では、サイクル数  $\phi_1$  をロウアドレスストローブ信号 RAS の立ち下がりに同期して開始しているが、カラムアドレスストローブ信号 CAS の立ち下がり

に指定されるものではなく、その裏面を決していない範囲で読み更可能であることはいうまでもない。例えば、第 1 図のタイミング制御回路 TC では、カウンタ回路 CTR をカウントダウンすることによってタイミング整合を行っているが、外部から供給されるシリアルタロック信号 SC のサイクル数  $\phi_1$  をレジスタに保持するとともにカウンタ回路 CTR をカウントアップさせ、カウンタ回路 CTR の出力とレジスタにセットされるサイクル数  $\phi_1$  とが一致したときにシリアル出力動作を開始させるようにしてよい。また、サイクル数  $\phi_1$  をデコードし、測定設けられるシフトレジスタの対応するビットに論理 “1” をセットした後、シリアルタロック信号 SC によってシフトレジスタをシフトさせ、この論理 “1” が所定の位置に達したことによってシリアル出力動作を開始させる方法もよい。この実施例では、サイクル数  $\phi_1$  をロウアドレスストローブ信号 RAS の立ち下がりに同期して開始しているが、カラムアドレスストローブ信号 CAS の立ち下がり

りに同期して供給するものであってもよい。さらに、第2回のデュアル・ポート・メモリは、一つのメモリアレイにより構成されるものであってもよいし、ランダム・アクセス・ポートの入出力回路R10に論理接続回路を設けないなど、そのプロック接続や制御信号の組み合わせ等、種々の実施形態を採りうるものである。

以上の実質では空として本発明者によってなされた発明をその背景となつた利用分野であるデュアル・ポート・メモリに適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、例えばシリアル入出力機能を持つ他の各種のマルチポート・メモリにも適用できる。本発明は、少なくともそのシリアル出力動作が外部から供給される制御信号及びクロック信号によって制御される半導体記憶装置には適用できる。

#### 〔発明の効果〕

本願において請求される実質のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、次のとおりである。すなわち、デュアル・ポート・

第3回は、第2回のデュアル・ポート・メモリにおける読み出しデータ伝送モードの一実施例を示すタイミング図。

第4回は、この発明に先立つて本願発明者等が開発したデュアル・ポート・メモリの読み出しデータ伝送モードを示すタイミング図である。

TC...タイミング制御回路、CTR...  
カウンタ回路、AC1~AC2...アンドゲート回路、NA01... NANDゲート回路、N1~N4...インバータ回路。

M-ARY1...メモリアレイ、SA1...  
センスアンプ、CSWI...カラムスイッチ、  
RCD...ランダム・アクセス・ポート用カラムアドレスデコーダ、SCD...シリアル・ア  
クセス・ポート用カラムアドレスデコーダ、RA  
DB...ロウアドレスバッファ、AMX...  
アドレスマルチプレクタ、CADB...カラム  
アドレスバッファ、REFC...リフレッシュ  
アドレスカウンタ、DRI...データレジスター、  
DSL1...データセレクタ、PNT...ス

メモリの読み出しデータ伝送モードにおいて、起動してから読み出しデータのデータ伝送動作を開始するまでの間のシリアルクロック信号のタイミングを指定し、タイミング制御回路TCに送られるカウンタ回路によってカウントダウンすることとし、シリアルクロック信号に同期し安定したタイミングで読み出しデータのシリアル出力動作を開始することができる。請求データのドットレートが高速化されるにもかかわらず、シリアルクロック信号及びCTRのスキャンタイミングに同期した読み出しデータのリアルタイム伝送を行うことができ、安定した表示速度を得ることができるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、この発明が適用されたデュアル・ポート・メモリのタイミング制御回路の一例の一実施例を示す回路図。

第2回は、第1回のタイミング制御回路を含むデュアル・ポート・メモリの一実施例を示すブロック図。

インク、R10...ランダム・アクセス・ポート用入出力回路、PC...機能制御回路、S10...シリアル・アクセス・ポート用入出力回路。

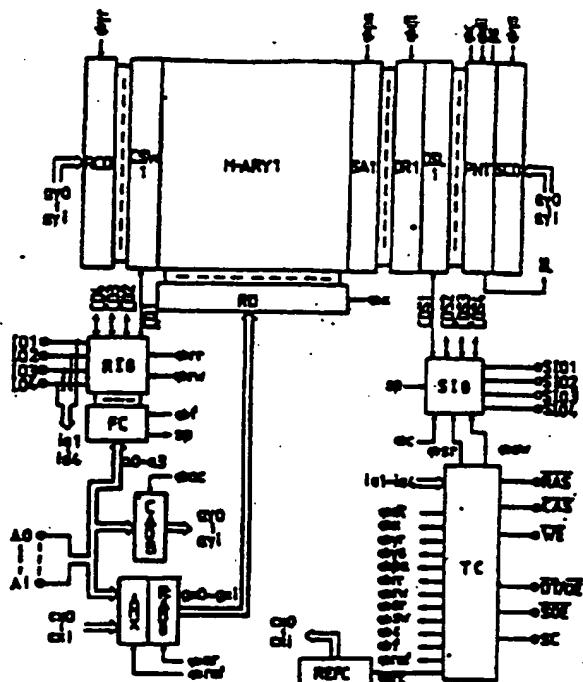
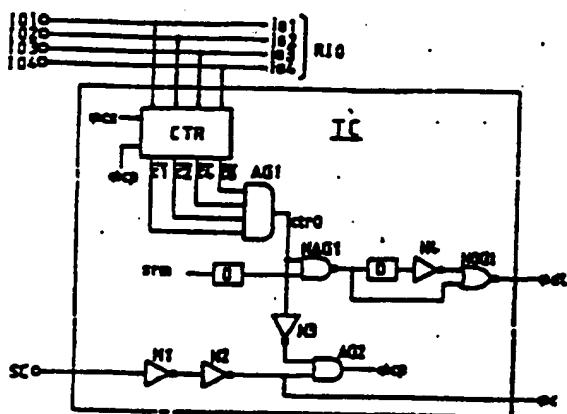
代理人弁護士

小川 錠

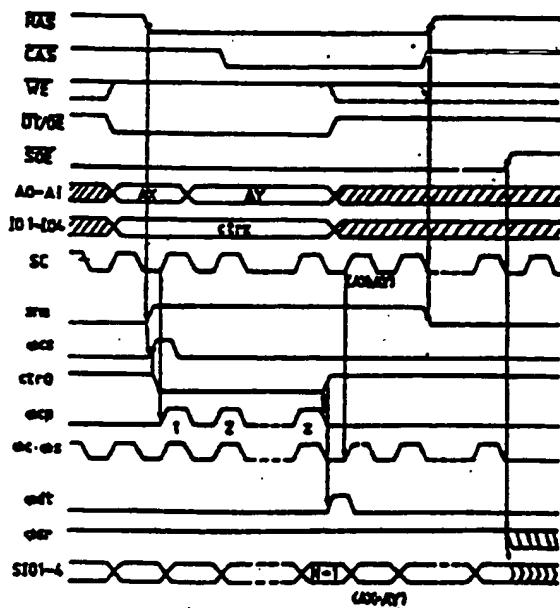


高 2 四

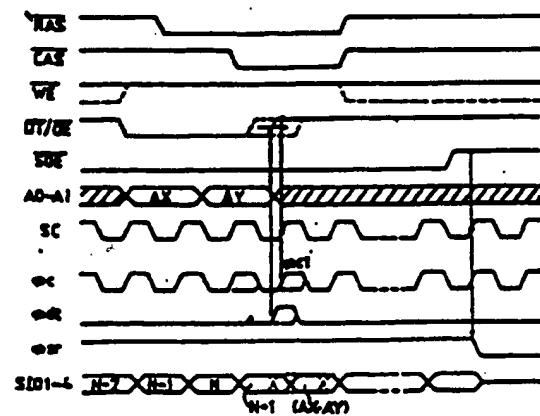
三一四



第3回



三 4



19) Japanese Patent Office (JP)  
(11) Patent Application Publication  
(12) Laid-Open Patent Publication (A) Sho 63-239676  
(51) Int. Cl.<sup>4</sup> Identification Code Office File No. (43) Publication: October 5, 1988  
G11C 11/34 362 G-8522-5B

Examination request: Not requested  
No. of inventions: 1  
(Total of 14 pages)

---

(54) Title of the Invention: Semiconductor memory device

(21) Patent Application: Shoe 62-71428

(22) Application: March 27, 1987

(72) Inventor: Yasunori [N.B. Other readings of first name possible.] Yamaguchi  
c/o Hitachi, Ltd. Device Development Center

2326 Imai, Oume-shi, Tokyo

(71) Applicant: Hitachi, Ltd.

4-6 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo

(74) Agent: Patent agent Masao [N.B. Other readings of first name possible.] Ogawa and one  
other

### Specifications

1. Title of the invention

Semiconductor memory device

2. Claims

1. A semiconductor memory device comprising:

a serial-parallel conversion circuit that receives a plurality of read data that is parallelly output over a plurality of data lines constituting a memory array and provides a serial output in accordance with a clock signal from an external source; and

a timing control circuit that controls the serial output operation of the aforesaid serial-parallel conversion circuit; and

characterized by:

the timing for starting the aforesaid serial output operation being set at will by specifying the number of cycles of the aforementioned clock signal required between activation by an activation control signal from an external source and the start of the aforementioned serial output operation.

2. A semiconductor memory device described in claim 1 characterized by the aforesaid timing control circuit comprising:

a counter circuit that obtains the aforesaid number of cycles from an external source in synchrony with the aforementioned activation control signal and then performs a count-down operation in accordance with the aforementioned clock signal; and a timing generation circuit which, upon detection of logical "0" for all bits in the output signal of the aforementioned counter circuit, creates an internal clock signal that is used for a serial output operation.

3. A semiconductor memory device described in claim 1 or claim 2 characterized by:  
the aforementioned semiconductor memory device being a dual port memory; and  
the aforementioned number of cycles being provided over a plurality of data input/output terminals for random access port use.

### 3. Detailed description of the invention

#### Field of industrial use

The present invention relates to semiconductor memory devices and in particular to an art that is effective, for example, when used with a dual port memory that is used for image processing and possessing both a random input/output function and a serial input/output function.

#### Prior art

A description of a frame buffer memory used with images to display characters, graphics, etc. on a CRT (cathode ray tube) screen is found, for example, in pages 243 through 264 of "Nikkei Electronics" dated March 24, 1986 published by Nikkei McGraw-Hill.

The dual port memory described in the aforesaid literature is provided with a random access port that is used for the input and output of memory data in one-bit units or several-bit units, and a serial access port that is used for the serial input and output of memory data in units of word lines in a memory array.

#### Problems to be solved with the present invention

As Fig. 4 shows, a dual port memory such as the above is provided with, as external control signals, row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$ , column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$  and write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  and additionally, for example, data transfer control signal  $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$ , serial output control signal  $\overline{\text{SOE}}$  and serial clock signal  $\text{SC}$ . With a dual port memory, the read data transfer mode - where the read data is serially output - is recognized when the levels of the column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$  and write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  are high and the level of the data transfer control signal  $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$  is low when the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  changes from high to low. At this time, the address  $\text{AX}$  of the word line to be read is provided to external terminals  $\text{A}0$  through  $\text{A}i$  in synchrony with the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  rising to high, and the read signals from the

memory cells that are connected to the selected word line are set up in the data lines. Also, in synchrony with the level of the column address strobe signal CAS falling to low which occurs with a slight delay following the level of the row address strobe signal RAS becoming low, the address AY of the first column that is to be serially output is supplied to external terminals A0 through Ai.

Thereafter, when the level of the data transfer control DT / OE is set back to high, timing signal sdt is generated - the timing signal sdt is used to transfer to the data register of the serial access port the read data that had been parallelly output to each of the data lines - and, along with that, an output operation is begun for the new serial data (data following (AX · AY)) that had been transferred to the data register in accordance with the timing signal sc which is generated in synchrony with the serial clock signal SC.

After the level of the data transfer control signal DT / OE is once set to low, the serial output operation begins when the level returns to high. The timing for this is controlled by monitoring the output signal of a counter circuit which counts the horizontal pixel location and which is provided in an external memory control circuit that drives the said dual port memory. To explain, when the output of the read data in the memory cells that are connected to one word line in a dual port memory is near completion, the dual port memory is reactivated and the read data in the memory cells of the new word line is output to the corresponding data lines. Thereafter, the level of the data transfer control signal DT / OE is returned to high while monitoring when the level of the serial clock signal SC becomes low which happens when the value of the counter circuit in the memory control circuit shows the end of the serial output operation for the read data from the memory cells connected to the preceding word line that had been selected. This then causes the read data in the memory cells that are connected to

the newly selected word line to be transferred to the data register and initiates a serial output operation. This allows a real time data transfer in synchrony with the CRT's dot rate.

However, improvements in display technology have resulted in the development of high-resolution CRTs which have increased the dot rate that determines the rate at which display data is serially output. This has resulted in a difficulty in maintaining a synchrony between the rising of the level of the data transfer control  $\overline{DT} / \overline{OE}$  and the serial clock signal SC. To explain, as described earlier, the timing for returning the level of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  to high is determined by monitoring the output signal of the counter circuit in the memory control circuit. This means that as the delay time involved in advancing the counter circuit using the serial clock signal SC, and the delay time involved in decoding and monitoring the output signal from the counter circuit begin to increase relative to the period of the serial clock signal SC, raising the level of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  in synchrony with the serial clock signal SC becomes difficult. As the dotted line in Fig. 4 shows, this results in a timing mismatch between the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  and the serial clock signal SC, and in particular, a delay in the level of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  rising with respect to the rise in the level of the serial clock signal SC. This then results in shortening the duration of the timing signal  $\delta dt$  which is used for transferring to the data register the read data from the memory cells that are connected to the newly selected word line. This results in an unstable serial data transfer operation and a disruption of the displayed images.

It is the object of the present invention to provide a semiconductor memory device such as a dual port memory with a stable serial data transfer operation.

The aforementioned object and other objects of the present invention and its new features will become apparent from the description in the specification and the attached figures.

## Means for solving the problems

The following is a brief description of an overview of a representative embodiment among the embodiments disclosed in the present application. To explain, during data transfer in a dual port memory, the timing for starting the transfer of data to the data register is set at will by specifying the number of clock signal cycles required between the activation of the data transfer cycle and the initiation of the transfer operation.

## Operation

When the data transfer operation is about to start in a dual port memory, the aforesaid means allows the clock signal position where the data transfer operation is to begin to be specified at will in accordance with the counter value of a counter circuit in a memory control circuit. Furthermore, since a count-down counter circuit provided within a dual port memory is used to perform the transfer operation in synchrony with a clock signal, a semiconductor memory device such as a dual port memory with a stabilized display data transfer operation is realized.

## Embodiments

Fig. 2 shows a block diagram of one embodiment of a dual port memory where the present invention is applied. The respective circuit blocks shown in the said figure are typically formed on, although not restricted to, a single semiconductor substrate such as a single crystal silicon using semiconductor integrated circuit fabrication technology of the public domain.

The dual port memory of this embodiment is provided with a random access port that is accessed in units of 4 bits and whose basic structural element is a dynamic RAM, and a serial access port where memory data is serially input and output in units of a word line. This allows the dual port

memory to engage in a series of serial input/output operations simultaneous with accesses made to the random access port. Also, although not restricted by this, a random input/output circuit RIO that is included in the random access port is provided with a logical operation circuit for performing raster operations, etc. A function control circuit that controls the said logical operation circuit is also provided. The logical operation circuit is provided with various operation functions such as logical multiplication and logical addition, and which operation to perform is specified with a [logical] operation code which is specified by particular combinations of the control signals which are input through external terminals A0 through A3 for the address signals.

The serial access port is provided with a serial input/output circuit SI0. Ordinarily, memory data corresponding to four memory arrays are simultaneously and serially input and output through four serial input/output terminals SI01 through SI04. However, a specific combination of [logical] operation codes can be used to specify the use as a memory with a x1 bit configuration wherein read data that are output from the four memory arrays are alternately output from input/output terminal SI01.

From an external device, in addition to row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$ , column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$ , write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  and other control signals which are used in ordinary dynamic RAMs, the dual port memory is provided with data transfer control signal  $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$  which is used for output control and for controlling the data transfer between the random access port and the serial access port, the serial output control signal  $\overline{\text{SOE}}$  which is used for controlling the switching between input and output operations by the serial access port, and the serial clock signal SC which is used as a synchronization signal during serial input and output operations.

Although not restricted by this, this embodiment of the dual port memory is provided with four memory arrays, M-ARY1 through M-ARY4, and sense amplifiers SA1 through SA4 and column

switches CSW1 through CSW4 which correspond to the respective memory arrays. A column address decoder RCD and a row address decoder RD, common to memory arrays M-ARY1 through M-ARY4, are also provided. A plurality of such address decoders may be provided depending on the arrangement of the memory arrays on a semiconductor substrate. Fig. 2 shows memory array M-ARY1 and its peripheral circuitry for illustration purposes.

In Fig. 2, memory array M-ARY1 comprises  $(m + 1)$  word lines that are arranged in a direction perpendicular to the said figure,  $(n + 1)$  sets of complementary data lines arranged in a direction horizontal with the said figure, and  $(m + 1) \times (n + 1)$  pieces of memory cells which are located at the intersections of the said word lines and complementary data lines.

The dynamic memory cells which configure the memory array M-ARY1 are constructed of capacitors for data storage and MOSFETs for address selection. The gates of the MOSFETs for address selection for the  $(n + 1)$  pieces of memory cells that are arranged along the same row are connected to the corresponding word line. Each word line is furthermore connected to the row address decoder RD so that one word line that is specified by the X address signal AX0 through AXi is specified and selected.

The row address decoder RD decodes the complementary internal address signals  $\underline{ax}0$  through  $\underline{ax}i$  (here the internal address signal, for example,  $ax0$ ) with the same phase and the internal address signal  $\overline{ax}0$  with the opposite phase as the X address signal AX0 that is supplied from an external source are collectively represented as complementary internal address signal  $\underline{ax}0$ ; the same convention is used hereinafter) that are supplied by row address buffer RADB, selects one word line that is specified by the X address signals AX0 through AXi and sets the selection state level to high. The selection operation of a word line by the row address decoder RD is performed in accordance with the word line selection timing signal  $\sigma x$  that is supplied by the timing control circuit TC.

The row address buffer RADB receives the row address signal from address multiplexer AMX, forms complementary internal address signals  $\underline{ax}_0$  through  $\underline{ax}_i$  and supplies the signals to the row address decoder RD. The dynamic RAM of this embodiment uses the so-called address multiplex method wherein the X address signals  $AX_0$  through  $AX_i$  which specify the row address and the Y address signals  $AY_0$  through  $AY_i$  which specify the column address are time-division multiplexed and supplied through the same external terminals  $A_0$  through  $A_i$ . The X address signals  $AX_0$  through  $AX_i$  which are supplied from an external source as control signals are fed to external terminals  $A_0$  through  $A_i$  in synchrony with the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falling, and the Y address signals  $AY_0$  through  $AY_i$  which are supplied from an external source as control signals are fed to external terminals  $A_0$  through  $A_i$  in synchrony with the level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  falling. Furthermore, the dynamic RAM of this embodiment is provided with an automatic refresh mode wherein data stored in the memory cells are read and rewritten using a prescribed period. Therefore, a refresh address counter REFC is provided to specify the word line to be refreshed in the automatic refresh mode.

In accordance with the timing signal  $\sigma_{ref}$  which is provided by the timing control circuit TC, the address multiplexer AMX selects the X address signals  $AX_0$  through  $AX_i$  that are supplied via external terminals  $A_0$  through  $A_i$  and the refresh address signals  $cx_0$  through  $cx_i$  supplied by refresh address counter REFC and transfers the signals to row address buffer RADB as row address signals. To explain, when the level of the timing signal  $\sigma_{ref}$  is low meaning an ordinary memory access mode, the address multiplexer AMX selects the X address signals  $AX_0$  through  $AX_i$  that are supplied by an external device via external terminals  $A_0$  through  $A_i$ ; when the level of the timing signal  $\sigma_{ref}$  is high meaning an automatic refresh mode, the address multiplexer AMX selects the refresh address signals  $cx_0$  through  $cx_i$  that are supplied by the refresh address counter REFC.

As afore-described, since the X address signals AX0 through AXi are supplied to external terminals A0 through Ai in synchrony with the falling level of the row address strobe signal RAS, the row address signals are obtained by the row address buffer RADB in accordance with the timing signal  $\sigma_{ar}$  which is generated by the timing control circuit TC by detecting the falling level of the row address strobe signal RAS.

The drains of the MOSFETs used for selecting the addresses of the memory cells that are formed along the same column in memory array M-ARY1 are connected to the corresponding complementary data line. One end of each complementary data line in memory array M-ARY1 is connected to the corresponding switch MOSFET of the column switch CSW1 and, furthermore, is selectively connected to the complementary common data line CD1 (here the noninverting signal line CD1 and inverting signal line CD1 of the complementary common data line are collectively represented as complementary common data line CD0; the same convention is used hereinafter.)

The column switch CSW1 comprises  $(n + 1)$  pairs of switch MOSFETs which are connected to their corresponding complementary data lines. The other ends of these switch MOSFETs are commonly connected to the noninverting signal line CD1 or inverting signal line CD1 which constitute the complementary common data line. This allows the column switch CSW1 to selectively connect  $(n + 1)$  sets of complementary data with common complementary data line CD1. The gates of the two switch MOSFETs in each pair which constitute the column switch CSW1 are commonly connected and are provided with the data line selection signal which is created by the column address decoder RCD for the random access port.

The column address decoder RCD for the random access port decodes the complementary internal address signals  $ay_0$  through  $ay_i$  that are supplied by the column address buffer CADB, and, in accordance with the data line selection timing signal  $\sigma_{yr}$  supplied by the timing control circuit TC,

forms the aforementioned data line selection signal which is then supplied to column switches CSW1 through CSW4.

The timing control circuit TC detects the falling level of the column address strobe signal CAS and generates the corresponding signal øac. In accordance with the signal øac, the column address buffer CADB receives and holds the Y address signals AY0 through AYi supplied through external terminals A0 through Ai and forms the complementary internal address signals ay0 through ayi which are then supplied to the column address decoder RCD for the random access port.

The other ends of each complementary data lines in memory array M-ARY1 are connected to the corresponding unit circuits of sense amplifier SA1 and furthermore to the corresponding unit circuits of data register DR1 of the serial access port.

Latches comprising two cross-connected CMOS inverter circuits are used as the basic structural elements of the unit circuits in sense amplifier SA1. Each of the said sense amplifier unit circuits is set in the operation mode by the timing signal øpa which is supplied by the timing control circuit TC, amplifies the micro-signals that are read from a memory cell and output to its corresponding complementary data line, and forms a binary signal with a high level or a low level.

The complementary common data line CD1 to which the complementary data line that is specified by the Y address signals AY0 through AYi is selectively connected is connected to the input/output circuit RIO for the random access port. Complementary common data lines CD2 through CD4 which are provided corresponding to memory arrays M-ARY2 through M-ARY4 are similarly connected to the random access port input/output circuit RIO.

When the dual port memory is in the random access port write operation mode, the random input/output circuit RIO, which is set in the operation mode by the timing signal ørw supplied by the timing control circuit TC, receives write data from an external device through input/output terminals

IO1 through IO4 and transfers the said write data as complementary write signals to the complementary common data lines CD1 through CD4. Furthermore, when the dual port memory is in the random access port read operation mode, the random input/output circuit RIO, which is set in the operation mode by the timing signal err supplied by the timing control circuit TC, receives binary signals that are read from the memory cells over complementary common data lines CD1 through CD4, amplifies the said binary signals and then outputs the said binary signals from input/output terminals IO1 through IO4. Although not restricted by this, the said random input/output circuit RIO is provided with a logical operation circuit that uses the read/modify/write function to perform various [logical] operations between the input data and data read from the memory cells and then rewrites the results. The said logical operation circuit is provided with various [logical] operation modes for performing processes such as a raster operation.

The operation mode of the logical operation circuit is specified by the function control circuit FC which comprises a register for holding the operation codes which are supplied through external terminals A0 through A3 and a decoder which decodes the said operation codes and selects and specifies the operation mode of the logical operation circuit. When the level of the column address strobe signal CAS is set to low before the row address strobe signal RAS is, and if the level of the write enable signal WE is low at the same time, the operation codes are supplied to the dual port memory via external terminals A0 through A3. Furthermore, the specific combinations of the operation codes are used as internal control signal sp which sets the output of the serial input/output circuit SIO described hereinbelow in the so called x1 bit configuration.

As described hereinbelow, when the dual port memory is in the serial read operation mode, the external terminals IO1 through IO4 for data input and output are provided with the number of cycles of the serial clock signal SC required for starting the serial output operation after the serial read

operation mode is activated. With the dual port memory of this embodiment, this arrangement allows the timing when the serial output mode will begin after its activation to be set at will and enables a serial output operation that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal SC whose period will be short when the dot rate is high. The data on the number of cycles that is supplied to external data input/output terminals IO1 through IO4 is sent to timing control circuit TC as internal signals io1 through io4.

The serial access port of the dual port memory of this embodiment comprises data registers DR1 through DR4 of  $(n + 1)$  bits corresponding to the complementary data lines in each memory arrays, data selectors DSL1 through DSL4, pointer PNT, column address decoder SCD for the serial access port and serial input/output circuit SIO, the latter three being commonly provided for the aforesaid four data registers and data selectors. Incidentally, depending on the layout of the memory arrays on a semiconductor substrate, a plurality of pointers PNT and a plurality of the column address decoders SCD for the serial access port may be provided.

Corresponding to the complementary data lines in the memory array M-ARY1, the data register DR1 includes  $(n + 1)$  pieces of flip-flops for data latching purpose. Switch MOSFETs for data transfer use are provided between the input/output nodes of the said flip-flops and their corresponding noninverting signal line and inverting signal line of the complementary data lines. Timing signal  $\phi_{dt}$  for data transfer use output by the timing control circuit TC is supplied to the gates of the aforesaid MOSFETs.

Each bit of the data register DR1 is connected to its corresponding switch MOSFET of data selector DSL1. The data selector DSL1, which is similarly constructed as the afore-described column switch SW1, selectively connects each bit of the data register DR1 with the complementary common data line CDS1 used for serial input and output. The gates of each pair of switch MOSFETs of data

selector DSL1 are commonly connected and are provided with the register selection signal from pointer PNT.

The pointer PNT comprises a latch circuit (pointer latch) which holds the serial operation start bit that is specified by the column address decoder SCD for the serial access port, shift register with (n + 1) bits, and a switch circuit consisting of an n-channel MOSFET that is provided between the aforesaid latch circuit and the aforesaid shift register. The output terminal ps for the last bit in the said shift register is connected to the input terminal for the first bit. Furthermore, the aforesaid timing signal  $\text{sd}t$  is commonly supplied to the gates of the aforesaid switch MOSFETs. When the dual port memory is in the serial input/output mode, the shift register of pointer PNT engages in a looping shift operation in accordance with the shift clock timing signal  $\text{sc}$  that is supplied by the timing control circuit TC. The selection signal that is held by the pointer latch circuit is supplied to the shifter register as its initial value when the level of the timing signal  $\text{sd}t$  becomes high.

The column address decoder SCD for the serial access port decodes the complementary internal address signals  $\text{ay}_0$  through  $\text{ay}_i$  which are supplied by the column address buffer CADB and sets only the bit of pointer PNT corresponding to the first bit of the serial input/output specified by the Y address signals  $\text{AY}_0$  through  $\text{AY}_i$  to a logical "1." To elaborate, when the serial input/output mode is being used, the word line si selected by the X address signals  $\text{AX}_0$  through  $\text{AX}_i$ , and Y address signals  $\text{AY}_0$  through  $\text{AY}_i$  specify the address of the first column where the serial input and output is to be performed. The logical "1" signal that is written to the specified bit of pointer PNT by the column address decoder SCD for the serial access port is shifted in a loop inside pointer PNT in accordance with timing signal  $\text{sc}$ . The said shifting of the logical "1" signal results in a register selection signal with a high level to be sequentially supplied to the data selector DSL1. This then results in each bit of data register DR1 to be successively connected to the complementary common data line  $\text{CDS}_1$  used

for serial input and output. With the dual port memory of the present embodiment, this arrangement allows the serial input and output of the memory data to be started from any desired column address which in turn allows processes like scrolling on an image memory to be performed at a high speed.

In the foregoing manner, when the dual port memory is in the serial read operation mode, the  $(n + 1)$  bits of read data that are output over  $(n + 1)$  sets of complementary data lines in memory array M-ARY1 are stored in data register DR1 when the level of timing  $\phi_{dt}$  becomes high. At the same time, with respect to pointer PNT, when the level of timing  $\phi_{dt}$  becomes high, the selection signal that is held by the pointer latch is transferred to the shift register as the initial value. In accordance with the register selection signal that is successively sent from pointer PNT, read data is sent to the serial input/output circuit SIO via the complementary common data line CDS1 for serial input and output. On the other hand, when the dual port memory is in the serial write operation mode, the write data which is serially sent from serial input/output terminal SIO1 via serial input/output circuit SIO is sequentially provided to the corresponding bit of the data register DR1 in accordance with the register selection signal that is successively sent from pointer PNT. When the level of timing  $\phi_{dt}$  changes to high, the write data which was stored in data register DR1 is written, all at once, to the  $(n + 1)$  pieces of memory cells which are connected to the selected word line in memory array M-ARY1.

The serial input/output circuit SIO includes a data input buffer, a data output buffer and four main amplifiers which are provided corresponding to serial input/output terminals SIO1 through SIO4 and complementary common data lines CDS1 through CDS4 used for serial input and output. When the dual port memory is in the read data transfer mode, the data output buffer of the serial input/output circuit SIO is set in the operation mode when the level of the timing signal  $\phi_{sr}$  from the timing control circuit TC becomes high, and the data that is output over the corresponding complementary common data lines CDS1 through CDS4 for serial input and output and then amplified by the corresponding

main amplifiers is output to an external device using the serial input/output terminals SIO1 through SIO4. When the dual port memory is in the serial write operation mode, the data input buffer of the serial input/output circuit SIO is set in the operation mode when the level of the timing signal  $\theta_{SW}$  from the timing control circuit TC becomes high, and the write data that is supplied from an external device over the corresponding serial input/output terminals SIO1 through SIO4 is transferred as complementary write data signals to the corresponding complementary common data lines CDS1 through CDS4 for serial input and output. The serial input/output circuit SIO performs the serial input and output operation on the memory data in accordance with timing signal  $\theta_C$  which is generated by the timing control circuit TC based on a serial clock signal SC that is supplied from an external source.

As described above, with the dual port memory of this embodiment, the serial output signal of the serial input/output circuit SIO is ordinarily output four bits at a time using the four serial input/output terminals SIO1 through SIO4. However, to realize a serial memory with a larger memory capacity, it is possible to use the dual port memory as a memory which the so-called x1 bit configuration where data that is read and output from four memory arrays, M-ARY1 through M-ARY4, is serially output through one serial input/output terminal. In this case, as mentioned earlier, one of the combinations of the operation codes which control the operation mode of the logical operation circuit in the random input/output circuit RIO is used as internal control signal  $sp$  which specifies a x1 bit configuration for the serial output. When the level of the said internal control signal  $sp$  from the function control circuit FC becomes high, a multiplexer that is provided in the serial input/output circuit SIO sequentially selects the read data that is serially output over the four sets of serial input/output complementary common data lines CDS1 through CDS4 and outputs to an external device using one serial input/output terminal SIO1. Since this serial output is performed in accordance

with timing signal  $sc$  from the timing control circuit TC, the data rate becomes the same as what the data rate would be for each input/output terminal had the four serial input/output terminals SIO1 through SIO4 been used to perform a serial output four bits at a time.

The timing control circuit TC receives from an external source, as control signals, row address strobe signal  $\overline{RAS}$ , column address strobe signal  $\overline{CAS}$ , write enable signal  $\overline{WE}$ , data transfer control signal DT/OE, and serial output control signal  $\overline{SOE}$  and forms the various aforesaid timing signals and supplies them to the different circuits. The timing control circuit also uses the serial clock signal SC supplied from an external source to generate the timing signal  $sc$  which is used for synchronizing the serial input/output operation and supplies the said signal to the serial input/output circuit SIO.

The operation mode of the dual port memory is specified by suitably combining the various control signals. For example, if the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  is low already and if, when the level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  becomes low, the level of the write enable signal  $\overline{WE}$  is high, the ordinary read operation mode using the random access port is selected. If the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  is low already and if, when the level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  becomes low, the level of the write enable signal  $\overline{WE}$  is low, the ordinary write operation mode using the random access port or the [logical] operation write operation mode is selected. Furthermore, if, when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls, the level of the write enable signal  $\overline{WE}$  is high and the level of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  is low, the read data in the memory array is transferred to data registers DR1 through DR4, and the so-called data transfer mode is selected for serially reading the data.

As described above, when the dual port memory of the present embodiment is in the data transfer mode, when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls to low, in synchrony with

this change in level, the number of cycles of the serial clock signal SC required from activation until the start of the next data transfer operation on the serial read data is set in external terminals IO1 through IO4 used for data input and output. Because of this, the timing control circuit TC is provided with counter circuit CTR which receives the data on the number of cycles via the data input/output terminals IO1 through IO4 and performs a count-down operation in accordance with the serial clock signal SC. The read data that is output to the respective data lines is transferred to data registers DR1 through DR4 in accordance with the timing signal  $\phi_{dt}$  which is generated when the value of counter circuit CTR in the timing control circuit TC becomes "0." The said data is then output by the serial input/output circuit SIO to the outside via serial input/output terminals SIO1 through SIO4 in accordance with the timing signal  $\phi_c$ .

Next, if, when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls, the levels of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  and the write enable signal  $\overline{WE}$  are both low and the level of the serial input/output control signal  $\overline{SOE}$  is high, the timing control circuit TC sets the dual port memory in the serial write operation mode, and the serial write data that is supplied via serial input/output terminals SIO1 through SIO4 is fed to data registers DR1 through DR4. On the other hand, if, when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls, the levels of the data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  and the write enable signal  $\overline{WE}$  are both low and the level of the serial input/output control signal  $\overline{SOE}$  is also low, the write data transfer mode is selected, and the transfer timing signal  $\phi_{dt}$  is generated. This sets the transfer switch MOSFETs of data registers DR1 through DR4 in an ON state. This results in the afore-described serial write operation mode, and the write data stored in data registers DR1 through DR4 are fed all at once to  $(n + 1)$  bits of memory cells that are connected to the selected word line in the memory array. The serial write operation using the serial access port of a dual port memory

is realized by executing the write data transfer mode in combination after executing the afore-described serial write operation mode.

On the other hand, if the level of the column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$  changes from high to low before the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  falls to low, the so-called  $\overline{\text{CAS}}$  before  $\overline{\text{RAS}}$  refresh mode is selected. Also, if the level of the write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  is already low when the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  falls, the [logical] operation mode setting cycle is selected, and the [logical] operation code which is supplied via external terminals A0 through A3 is stored in the register in the function control circuit FC.

With all of the operation modes other than the afore-described [logical] operation mode setting cycle, the X address signals AX0 through AXi which specify the word line are supplied to the external terminals A0 through Ai in synchrony with the falling level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$ . Also, if a particular operation mode requires a column address, the Y address signals AY0 through AYi which specify the complementary data line are supplied to the external terminals A0 through Ai in synchrony with the falling level of the column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$ .

Fig. 1 shows a circuit diagram of a part of one embodiment of the timing control circuit TC for a dual port memory shown in Fig. 2.

As previously stated, with the dual port memory of this embodiment, the data input/output external terminals IO1 through IO4 are used to specify, using a binary representation, the number of cycles of the serial clock signal SC that is required from the activation of the dual port memory by the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  becoming low until the start of the data transfer operation on the read data. The said number of cycles is supplied as internal data io1 through io4 to the corresponding bits in the counter circuit CTR in the timing control circuit TC.

Another timing generating circuit is provided within timing control circuit TC, and from the said other timing generating circuit, the counter circuit CTR receives the timing signal  $\text{ocs}$  which is generated in synchrony with the falling level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$ . The counter circuit CTR also receives the [counter] advancing timing signal  $\text{ocp}$  which is created within the timing control circuit TC shown in the said figure.

The inverted output signals  $\overline{C_1}$  through  $\overline{C_8}$  from each bit in the counter circuit CTR are supplied to the four input terminals of the AND gate circuit AG1. The level of the output signal  $\text{ctr0}$  of the AND gate circuit AG1 is set to high when the inverted output signals  $\overline{C_1}$  through  $\overline{C_8}$  of the counter circuit CTR are all logical "0," that is, when the value of the counter circuit CTR becomes "0."

The output signal  $\text{ctr0}$  of the AND gate circuit AG1 is fed to one input terminal of the NAND gate circuit NAG1 and, after the said output signal has been inverted by inverter circuit N3, also to one input terminal of the AND gate circuit AG2. The other input terminal of the NAND gate circuit NAG1 receives the output signal  $\text{srn}$  from a flip-flop which is not illustrated after the said output signal  $\text{srn}$  has passed through a suitable delay means (for example, an even number of inverter circuits). The said output signal  $\text{srn}$  from the flip-flop which is not illustrated is set if, when the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  falls from high to low, the levels of the column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$  and the write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  are high and the level of the data transfer control signal  $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$  is low. In other words, the output signal  $\text{srn}$  of the said flip-flop is used as a mode signal which specifies the read data transfer cycle of the dual port memory. Given this setup, the level of the output signal of the NAND gate circuit NAG1 becomes low when the levels of the output signal  $\text{ctr0}$  of the AND gate circuit AG1 and the mode signal  $\text{srn}$  are high. The output signal of the NAND gate circuit NAG1 is delayed by a suitable delay means D, inverted by inverter circuit N4 and then fed to one of the input terminals of the NOR gate circuit NOG1 while the output signal of the NAND gate

circuit NAG1 is also fed directly to the other input terminal of the NOR gate circuit NOG1. The output signal of the NOR gate circuit NOG1 is fed to pointer PNT as timing signal  $\text{sd}t$ . In other words, when the level of the mode signal  $\text{sm}$  is high which means that the dual port memory is in the read data transfer mode, the level of the timing signal  $\text{sd}t$  is temporarily set to high for a prescribed amount of time when the level of the output signal  $\text{ctr}0$  of the AND gate circuit AG1 is high.

Serial clock signal SC that has passed through inverter circuits N1 and N2 is fed to the other input terminal of the AND gate circuit AG2. This means that the level of the output signal of the AND gate circuit AG2 becomes high when the level of the output signal  $\text{ctr}0$  of the AND gate circuit AG1 is low, the level of the output signal of the inverter circuit N3 is high, that is, when the value of the counter circuit CTR is not "0," and the level of the serial clock signal SC is high. In other words, the output signal of the AND gate circuit AG2 serves as a timing signal  $\text{sc}p$  which advances and counts down the counter circuit CTR until the value of the counter circuit CTR becomes "0." Also, the serial clock signal SC that has passed through inverter circuits N1 and N2 becomes timing signal  $\text{sc}$ .

Fig. 3 shows a timing chart of one embodiment which is used to explain the operation of the read data transfer mode for a dual port memory that includes the timing control circuit TC shown in Fig. 4 [sic]. An overview of the read transfer mode of the dual port memory of this embodiment is explained with reference to Fig. 3.

In Fig. 3, the dual port memory is activated when the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  changes from high to low. Prior to the level of the row address strobe signal  $\overline{\text{RAS}}$  falling from high to low, the levels of the column address strobe signal  $\overline{\text{CAS}}$  and write enable signal  $\overline{\text{WE}}$  are set to high, and the level of the data transfer control signal  $\overline{\text{DT}} / \overline{\text{OE}}$  is set to low. The X address signals  $\text{AX}_0$  through  $\text{AX}_i$  which specify the word line are fed to the external terminals  $\text{A}_0$  through  $\text{A}_i$ , and the number of serial clock signal SC cycles  $\text{ctr}z$  which must elapse between the level of the row address

strobe signal  $\overline{RAS}$  falling and the start of the serial output operation on the read data is fed to external terminals IO1 through IO4 used for data input and output.

The number of cycles  $ctrz$  is determined by the counter value of a counter circuit which is included in a memory control circuit that is external to the dual port memory and which is used for controlling the horizontal pixel location on a CTR [sic]. To explain, letting N1 represent the counter value corresponding to the last bit in one word line worth of read data and N2 represent the counter value when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  is to fall, the number of cycles  $ctrz$  is determined as follows:

$$ctrz = N1 - N2$$

The number cycles  $ctrz$  is set to a suitable value that satisfies the above equation while providing more time than is necessary to set a read data in the random access port of a dual port memory.

The level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  changes from high to low with a slight delay after the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls. Prior to the level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  falling from high to low, the address of the data line that should be output first during a serial output operation is supplied to external terminals A0 through Ai as Y address signals AY0 through AYi. The levels of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$ , column address strobe signal  $\overline{CAS}$ , write enable signal  $\overline{WE}$  and data transfer control signal  $\overline{DT} / \overline{OE}$  are returned to high after the counter value of the counter circuit CTR has become "0" and the serial output operation has been started.

With the dual port memory, when the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls, the X address signals AX0 through AXi are stored in the row address buffer RADB, and a word line selection operation is performed. When the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  falls, the level

of the mode signal  $s_{RM}$  is set to high, the timing signal  $\phi_{CS}$  is generated, and the number of cycles  $ctr_2$  which is supplied to external terminals IO1 through IO4 used for data input and output are stored in the counter circuit CTR. This makes the output of the counter circuit CTR to a value other than "0," and the level of the output signal  $ctr_0$  of the AND gate circuit AG1 shown in Fig. 1 becomes low.

When the level of the output signal of the said AND gate circuit AG1 becomes low, that is, when the level of the output signal of the inverter circuit N3 becomes high, the output signal of the AND gate circuit AG2, that is, the timing signal  $\phi_{CP}$  for advancing the counter circuit CTR is generated.

Whenever the level of the said timing signal  $\phi_{CP}$  becomes low, the counter circuit CTR counts down from the value of the number of cycles  $ctr_2$  that was initially stored toward the value of "0."

While the counter circuit CTR is counting down the serial clock signal SC, the word line selection operation is completed in the dual port memory, and the data that is read from the  $(n + 1)$  memory cells that are connected to the selected word line is set in their corresponding complementary data lines. Also, when the level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$  falls, the Y address signals  $AY_0$  through  $AY_i$  are received, and the column address decoder SDC for the serial access port begins selecting a data line. At the same time that the said column address decoder SCD for the serial access port completes the decoding process, the timing signal  $\phi_{YS}$  is created, and a logical "1" is set in the bits of pointer PNT corresponding to the Y address signals  $AY_0$  through  $AY_i$ .

As the counter circuit CTR counts down and when the counter value become "0," the level of the output signal  $ctr_0$  from the AND gate circuit AG1 becomes high which causes the level of the output signal of the inverter circuit N3 to become low and stops the timing signal  $\phi_{CP}$  which is used for advancing the counter circuit CTR. Also, timing signal  $\phi_{DT}$  is created and the read data that had been set in each of the data lines is transferred to data registers DR1 through DR4. Furthermore, timing

signal  $\text{osr}$  is generated in synchrony with the serial output control signal  $\overline{\text{SOE}}$  which controls the data output buffer DOB of the serial input/output circuit SIO.

With the timing signal  $\text{osr}$  at a high level, the serial input/output terminals SIO1 through SIO4 changes from a high-impedance state Hz to a level commensurate with the read data in the first address specified by Y address signals AY0 through AYi. This commences the output operation of the read data.

With the levels of the mode signal  $\text{sm}$  and the output signal  $\text{ctr0}$  of the AND gate circuit AG1 being high, the timing control circuit TC generates timing signal  $\text{sc}$  which is used for shifting and is synchronized with the serial clock signal SC. The said timing signal  $\text{sc}$  is supplied to the serial input/output circuit SIO and the pointer PNT. This causes the logical "1" signal that had been set by the selection operation of the column address decoder SCD for the serial access port in the bits of pointer PNT corresponding to the Y address signals AY0 through AYi to shift in a loop. This causes the read data that had been stored in data registers DR1 through DR4 to be output to serial input/output terminals SIO1 through SIO4 via the serial input/output circuit SIO and the complementary common data lines  $\text{CDS1}$  through  $\text{CDS4}$  for serial input/output use. The shifting of the pointer PNT with the timing signal  $\text{sc}$  happens in synchrony with the level of the said timing signal rising from low to high. The pointer PNT ignores the first pulse from the timing signal  $\text{sc}$  so as to secure an output time width for the first data.

As the serial output operation for the read data progresses as dictated by the timing signal  $\text{sc}$  and when the last read data is output, the level of the serial output control signal  $\overline{\text{SOE}}$  is returned to high which causes the level of the mode signal  $\text{sm}$  to become low which, in turn, causes the level of the serial output timing signal  $\text{osr}$  to be set to low in synchrony with the level of the serial clock signal

SC rising to high. This stops the serial output operation of the dual port memory, and the serial input/output terminals SIO1 through SIO4 are set in a high-impedance state.

As the foregoing description shows, when the dual port memory of the present embodiment is in the read data transfer mode, the number of cycles  $ctrz$  of the serial clock signal SC required between the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  becoming low and the start of the serial output operation of the read data is specified in synchrony with the level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$  becoming low. The said number of cycles  $ctrz$  is set in the counter circuit CTR in the timing control circuit TC as an initial value for starting the count down operation. When the counting down by the counter circuit CTR ends and the counter value become "0," the serial output operation of the read data is begun. This allows the serial output operation of the dual port memory to be performed in accurate synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic] and thereby provides stable displayed images even when an external high-resolution CTR [sic] with an extremely high dot rate for the displayed data is used.

As the foregoing description of the present embodiment shows, a semiconductor memory device such as a dual port memory that uses the present invention for image processing provides the following effects, namely:

- (1) When a dual port memory is in the read data transfer mode, by specifying - in synchrony with the activation control signal - the number of cycles of the serial clock signal between the activation and the start of the serial output operation on the read data and by counting down using the counter circuit provided in the timing control circuit TC, the serial output operation on the read data can be started with a timing that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal.

(2) Because of (1) above, a real time transfer of the read data can be performed in accurate synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic] and thereby provides stable displayed images even when an external high-resolution CTR [sic] with an extremely high dot rate for the displayed data is used.

The invention made by the inventor has been described hereinbefore in concrete terms using one embodiment of the invention, but the present invention is not restricted by the said embodiment. Needless to say, various modifications are possible without deviating from the gist of the invention. For example, the timing control circuit TC of Fig. 1 coordinates the timing by performing a count down operation with the counter circuit CTR. However, it is also acceptable to store the number of cycles  $ctrz$  of the serial clock signal SC supplied from the outside in a register and to count up the counter circuit CTR and to start the serial output operation when the output of the counter circuit CTR matches the number of cycles  $ctrz$  set in the register. It is also acceptable to decode the number of cycles  $ctrz$ , set a logical "1" in the corresponding bit of a separately provided shift register, shift the said shift register using the serial clock signal SC, and start the serial output operation when the said logical "1" has reached a prescribed position. With the present embodiment, the number of cycles  $ctrz$  is provided in synchrony with the falling level of the row address strobe signal  $\overline{RAS}$ , but it is also acceptable to do this in synchrony with the falling level of the column address strobe signal  $\overline{CAS}$ . Furthermore, it is acceptable for the dual port memory shown in Fig. 2 to comprise only one memory array or for the input/output circuit RIO for the random access port to be not provided with a logical operation circuit. In this manner, various modifications are possible in the block configuration, the combination of the control signals, etc. that are used.

Even though the description hereinbefore of the present invention was provided as applied to a dual port memory, the present invention is not restricted to use with dual port memories. For example,

the present invention can be used with various multi-port memories with a serial input/output function. At least, the present invention can be used with semiconductor memory devices whose serial output operation is controlled by control signals and a clock signal that are provided from an external source.

#### Effects of the invention

The effects that are obtained from the representative example of the invention disclosed in this application are as follows. To explain, when a dual port memory is in the read data transfer mode, by specifying the number of cycles of the serial clock signal between activation and the start of the data transfer operation on the read data and by counting down using the counter circuit provided in the timing control circuit TC, the serial output operation on the read data can be started using a timing that is synchronized in a stable manner with the serial clock signal, and since a real time transfer of the read data can be performed in synchrony with the serial clock signal SC and the scanning timing of the CTR [sic], stable displayed images are obtained even when the dot rate of the displayed data is increased.

#### 4. Brief description of the figures

Fig. 1 is a circuit diagram showing a part of one embodiment of a timing control circuit of a dual port memory that uses the present invention.

Fig. 2 is a block diagram showing one embodiment of a dual port memory that includes the timing control circuit shown in Fig. 1.

Fig. 3 is a timing chart of one embodiment of the read data transfer mode in a dual port memory shown in Fig. 2.

Fig. 4 is a timing chart for the read data transfer mode in a dual port memory which was developed by the inventor of the present application in concert with other individuals before the present invention.

TC:	Timing control
CTR:	Counter circuit
AG1 through AG2:	AND gate circuits
NAG1:	NAND gate circuit
N1 through N4:	Inverter circuits
M-ARY1:	Memory array
SA1:	Sense amplifier
CSW1:	Column switch
RCD:	Column address decoder for the random access port
SCD:	Column address decoder for the serial access port
RADB:	Row address buffer
AMX:	Address multiplexer
CADB:	Column address buffer
REFC:	Refresh address counter
DR1:	Data register
DSL1:	Data selector
PNT:	Pointer
RIO:	Input/output circuit for the random access port
FC:	Function control circuit
SIO:	Input/output circuit for the serial access port

Agent: Patent agent Masao Ogawa [Seal: Illegible]

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

CAS  
CAS

WE  
WE

SOE  
SOE

OE  
OE

DT / OE  
DT / OE

RAS  
RAS

RAS  
RAS

CD1

CD1

C1  
C1

C8  
C8

PA 3108111 v1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**